

## 軽金属,「私の一枚」シリーズより 工業用純アルミニウム中のシリコンリング\*

## 吉田 英雄\*\*

## Si-ring in Commercially Pure Aluminum

Hideo Yoshida\*\*

約30年前,純アルミニウム1050の冷間圧延材の焼鈍 による軟化特性を調査していて,Fig.1に示すような 275℃付近で急に伸びが高くなる現象を見つけた<sup>1)</sup>。も ちろん過去には気づかれた方も多いと思う。これは何 故だろうと,当時新人の森山勉君がミクロ組織を観察 していたら,黒い点状の粒子のものが数多くあり,最 初はゴミか何か付着したものではないかと疑いながら 調べた。SEMで観察するとこの粒子はリング状になっ ていて,EDS分析をするとケイ素が出てくる(以下, これをシリコンリングと呼ぶ)。これは何かあると考 え,さらにTEMで調査をすすめた。

TEMで観察すると、やはり275℃付近で、Fig. 2に 示すような亜結晶粒や再結晶粒の粒内にシリコンリン グが最も多く観察された<sup>2),3)</sup>。この温度域は再結晶粒 と亜結晶粒の混粒組織になっている。300℃以上になる



Fig. 1 Annealing curves of an 1050 cold-rolled sheet.

とシリコンリングは少なくなり、350℃では観察されな い。このシリコンリングの径は何で決まるのだろうか と調べていくと、Fig. 3 a), b)からわかるように転位 セルのサイズにぴったり合う。このシリコンリングは 電子線回折から粒状の単結晶シリコンがリング状に集 まったもので多結晶体であることがわかった<sup>2).3)</sup>。回 復過程で固溶したあるいは転位に捕まったケイ素がマ トリックスから排出され、その粒界に偏析ないしは析 出して粒界移動を抑制し、凝集化することで粒界を離 れていくことがわかる。さらに高温では鉄も同様に偏 析・析出してくる。Fig. 4は亜結晶粒界に偏析した鉄 やケイ素を示す<sup>4)</sup>。撮影には九州大学のHAADF-STEM分析電子顕微鏡を用いた。固溶した不純物元素 が粒界に偏析・析出、凝集化することで亜結晶粒や再 結晶粒の成長は制御されているとの観点で再結晶速度



Fig. 2 Si rings formed in an 1050 aluminum sheet annealed at 275°C. But these rings disappeared at more than 300°C.

\* 「軽金属」(64 (2014), 179)の「私の一枚」シリーズに掲載されたものに加筆。 Revision of "Si-ring in pure aluminum" reprinted from "My one shot" series in Journal of Japan Institute of Light Metals, 64 (2014), 179.

\*\* (株) UACJ 技術開発研究所 Research & Development Division, UACJ Corporation



a) As cold rolled



b)  $150^{\circ}C/1$  h annealed



c)  $200^{\circ}C/1$  h annealed

Fig. 3 Formation of silicon-ring on dislocation cell boundaries, (a) dislocation cells in a cold-rolled sheet, (b) Si-ring formed on the dislocation cell boundary annealed at 150°C for 1 h and (c) Si-ring left from this boundary annealed at 200°C for 1 h.

論をまとめ,昨年の軽金属学会で講演発表した<sup>5)</sup>。こ の発表内容をまとめ,ICAA14<sup>6)</sup>での講演発表や「軽金 属」に論文投稿し<sup>7)</sup>,本誌にも転載されている<sup>8)</sup>。また 伸びが275℃付近で最大となり,さらに高温になると低 下する。さらに,150℃付近では伸びが最も低下し,ほ とんど伸びがないことも生じる。これら伸びの極大極 小の原因については,浅野君らの若手の研究グループ が解明しようとしている<sup>9)</sup>。Fig. 3が軽金属に掲載され た「私の一枚」である。



Fig. 4 STEM and EDS mapping images of the sample annealed at 250°C for 50 min. (a) HAADF-STEM image, (b) Bright field image, and EDS mapping image of (c) Si, and (d) Fe.

## 参考文献

- 森山勉,吉田英雄:第68回軽金属学会春期大会講演概要, (1985),217.
- 2) 森山 勉, 吉田英雄, 土田 信: 軽金属, 39 (1989), 184-189.
- 森山 勉, 吉田英雄, 土田 信:住友軽金属技報, 30 (1989), 1-7.
- 浅野峰生,中村拓郎,吉田英雄:軽金属, 64 (2014), 279-284
- 5) 吉田英雄, 大久保喜正:第124回春期大会講演概要 (2013), 201.
- H. Yoshida and Y. Ookubo: Aluminium Alloys 2014-ICAA14, Trondheim, Materials Science Forum Vols. 796 (2014), 734-739.
- 7) 吉田英雄, 大久保喜正: 軽金属, 64 (2014), 285-291.
- 8) 吉田英雄, 大久保喜正: UACJ Tech. Rep., 1 (2014), 45-54.
- 9) 中村拓郎, 浅野峰生, 吉田英雄, 嶋田雄介: 第125 回秋期大 会講演概要 (2013),117.



吉田 英雄 (Hideo Yoshida) (株) UACJ 技術開発研究所